



Toshiba stellt zwei neue 80V n-Kanal-Leistungs-MOSFETs vor

Basierend auf dem U-MOSX-H-Prozess werden die neuen Bausteine den Wirkungsgrad bei der Stromversorgung deutlich verbessern

Düsseldorf, 30. März 2020 – Toshiba Electronics Europe (“Toshiba”) stellt zwei neue 80V n-Kanal-Leistungs-MOSFETs auf Basis des neuesten U-MOSX-H-Prozess vor. Beide Bausteine eignen sich für verschiedenste Stromversorgungs -Anwendungen, bei denen ein verlustarmer Betrieb wichtig ist, u.a. für die hocheffiziente AC/DC- und DC/DC-Wandlung in Rechenzentren und Basisstationen sowie einer Vielzahl von Antriebssteuerungen.

Der TPH2R408QM und TPN19008QM sind 80V-U-MOSX-H-Bausteine, die im Vergleich zu entsprechenden 80V-Leistungs-MOSFETs auf Basis früherer Prozesse wie U-MOSVIII-H einen um 40% geringeren Durchlasswiderstand ($R_{DS(ON)}$) aufweisen. Folglich bietet der

TPN19008QM einen $R_{DS(ON)}$ -Wert von $19\text{m}\Omega$ (max.) und der TPH2R408QM einen Wert von nur $2,43\text{m}\Omega$.

Durch einen optimierten Aufbau wurde das Produkt aus $R_{DS(ON)}$ und Gate-Ladung um bis zu 15% und das Produkt aus $R_{DS(ON)}$ und Ausgangsladung um 31% verbessert. Zusammen mit dem verbesserten $R_{DS(ON)}$ weisen die neuen Leistungs-MOSFETs die branchenweit niedrigste Verlustleistung auf.

Beide Bausteine werden in SMD-Gehäusen ausgeliefert und sind für eine Drain-Source-Spannung (U_{DSS}) von 80V ausgelegt. Die maximale Kanaltemperatur (T_{ch}) beträgt 175°C . Der TPN19008QM ist für einen Drainstrom (I_D) von 34A ausgelegt und befindet sich in einem $3,3\text{mm} \times 3,3\text{mm}$ TSON-Advance-Gehäuse, während der TPH2R408QM für einen I_D von 120A ausgelegt und im $5\text{mm} \times 6\text{mm}$ SOP-Advance-Gehäuse verfügbar ist.

Die schrittweise Auslieferung der neuen Bausteine beginnt ab sofort.

Weitere Informationen über Toshibas Angebot von 12-300V-MOSFETs unter:

<https://toshiba.semicon-storage.com/eu/product/mosfet/lv-mosfet.html>

###

Über Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) ist der europäische Geschäftszweig für elektronische Komponenten [Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation](#) (Toshiba). TEE bietet europäischen Kunden und Unternehmen eine umfangreiche, innovative Auswahl an Hard Disk Drives (HDD) sowie Halbleiter Lösungen für Automotive, Industrie IoT, Motor Control, Telekommunikation und Netzwerktechnik oder für Endverbraucher- und Haushaltsgeräte-Applikationen. Das Produktsortiment des Unternehmens umfasst integrierte Wireless ICs, Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, optische Halbleiter, ASSPs und diskrete Komponenten, von Dioden bis hin zu Logic-ICs.

Zum Hauptsitz in Düsseldorf gehören Zweigstellen in Frankreich, Italien, Schweden, Spanien und Großbritannien. Von dort aus werden Design, Marketing und Vertrieb bereitgestellt. Präsident des Unternehmens ist Mr. Tomoaki Kumagai.

Weitere Informationen über Toshiba Electronics Europe unter: www.toshiba.semicon-storage.com.

Ansprechpartner für Veröffentlichungen:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Deutschland
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197
Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html
E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Ansprechpartner für die Presse:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH
Tel: +44 (0) 1932 822 832
E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Herausgegeben durch:

Birgit Schöniger, Publitek
Tel: +44 (0) 1582 390980
Web: www.publitek.com
E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

März 2020

Ref. 7251